

慶應義塾大学試験問題 物理学 D

(試験時間 50 分)

注意：とくに指示がない場合、答案には結果のみならず、それを導いた過程についても記すこと。また、万が一与えられた条件だけでは解けない場合には、適当な量を定義したり、条件を明記した上で解いてよい。電気定数 ε_0 、磁気定数 μ_0 、真空中の光速 c の記号は断りなしに使ってよい。

問題 I 極板間の距離が d 、両極板の面積が S の平行平板コンデンサーを考える。図 I のように、一方の極板が $x = 0$ の面内に、もう一方の極板が $x = d$ の面内にあるように、デカルト座標系 (x, y, z) をとる。 x, y, z 軸の正の方向の単位ベクトルを、それぞれ、 $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$ とし、ベクトル量はこれらを用いて表すものとする。極板間 $0 < x < d$ には誘電体があり、その誘電率が x の関数として $\varepsilon(x) = \bar{\varepsilon}\varepsilon_0 \left(1 + \alpha \frac{x}{d}\right)^2$ のように変化している。ここで、 $\bar{\varepsilon}, \alpha$ は正の定数であり、 $\bar{\varepsilon} > 1$ を満たす。 $x = 0$ にある電極に正の電荷 Q を、 $x = d$ にある電極に負の電荷 $-Q$ を与える。極板の端からの電界の漏洩は無視できるものとする。

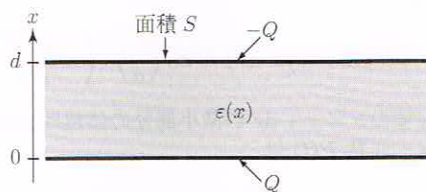


図 I

- (1) 極板間の電界 \mathbf{E} 、電束密度 \mathbf{D} 、電気分極 \mathbf{P} を求めなさい。
- (2) この系の静電エネルギー U_E を求めなさい。
- (3) 誘電体の $x = 0$ の表面の分極電荷面密度 $\omega_P^{(x=0)}$ と $x = d$ の表面の分極電荷面密度 $\omega_P^{(x=d)}$ を求めなさい。さらに、誘電体内部 (表面以外) の分極電荷密度 ρ_P を求めなさい。

問題 II 物質中で、電界を \mathbf{E} 、電束密度を \mathbf{D} 、磁束密度を \mathbf{B} 、磁界を \mathbf{H} 、真電荷密度を ρ_t 、真電流密度を \mathbf{i}_t とする。

- (1) 物質中のマクスウェル方程式を書きなさい。
- (2) 物質が一様で、その誘電率 ε と透磁率 μ が一定の場合を考える。デカルト座標系 (x, y, z) を使い、ベクトル量は問題 I で定義した単位ベクトル $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$ で表すものとする。 $\rho_t = 0$ 、 $\mathbf{i}_t = \mathbf{0}$ で、時刻 t 、位置 (x, y, z) において $\mathbf{E}(x, y, z, t) = E_z(y, t)\mathbf{e}_z$ 、 $\mathbf{B}(x, y, z, t) = B_x(y, t)\mathbf{e}_x$ と与えられる平面電磁波を考える。 $E_z(y, t)$ の従う波動方程式を書きなさい。さらに、その一般解を、2 回以上微分可能な 2 つの任意の関数 $f(\xi), g(\eta)$ を用いて書きなさい。このとき、 $B_x(y, t)$ がどのように表されるか書きなさい。ただし、 t に依存しない項は 0 とする。
- (3) 電磁場のエネルギー密度を u 、ポインティングベクトルを \mathbf{S} とする。(1) のマクスウェル方程式を用いて、 u の時間変化に関する式

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\operatorname{div} \mathbf{S} - \mathbf{i}_t \cdot \mathbf{E}$$

を導きなさい。また、右辺の各項の物理的意味を説明しなさい。

ヒント: $\mathbf{E} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{H} - \mathbf{H} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{E} = \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) - \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) = -\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = -\operatorname{div}(\mathbf{E} \times \mathbf{H})$

が成立する。

問題 III 無限に広い厚さの無視できる 2 枚の導体板を、互いに平行で、導体板間の距離が d となるように配置されている。図 III のように、一方の導体板が $x = 0$ の面内に、もう一方の導体板が $x = d$ の面内にあるように、デカルト座標系 (x, y, z) をとる。ベクトル量は問題 I で定義した単位ベクトル e_x, e_y, e_z を用いて表すものとする。極板間 $0 < x < d$ には磁性体があり、その透磁率が x の関数として $\mu(x) = \bar{\mu}\mu_0 \left(1 + \alpha \frac{x}{d}\right)^2$ のように変化している。ここで、 $\bar{\mu}, \alpha$ は正の定数であり、 $\bar{\mu} > 1$ を満たす。 $x = d$ にある導体板に面電流密度 $i_s = i_s e_y$ が、 $x = 0$ にある導体板に面電流密度 $-i_s = -i_s e_y$ が流れている。ここで、 i_s は正の定数である。

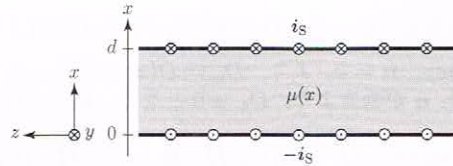


図 III

- (1) 位置 (x, y, z) における磁束密度 $B(x, y, z)$ 、磁界 $H(x, y, z)$ 、磁化 $J(x, y, z)$ を求めなさい。
- (2) 磁性体の $x = d$ の表面上の位置 (d, y, z) における面磁化電流密度ベクトル $\mathcal{I}_m(d, y, z)$ と、磁性体の $x = 0$ の表面上の位置 $(0, y, z)$ における面磁化電流密度ベクトル $\mathcal{I}_m(0, y, z)$ を求めなさい。
- (3) 磁性体内の位置 (x, y, z) における磁化電流密度 $i_m(x, y, z)$ を求めなさい。

問題 IV 半径 a の無限に長い導体円柱棒がある。導体円柱棒の中心軸を z 軸にとり、 z 軸に垂直な平面内の位置を 2 次元極座標 (r, φ) で表した円柱座標系 (r, φ, z) を用いて考える。 z 軸の正の向きの単位ベクトルを e_z とする。位置 (r, φ, z) において、 z 軸に垂直で z 軸から遠ざかる方向の単位ベクトルを e_r 、 z 軸を中心に回転する方向 (右ねじが e_z 方向に進む方向) の単位ベクトルを e_φ とする (図 IV-1 参照)。互いに直交するこれらの単位ベクトル e_r, e_φ, e_z を用いて位置 (r, φ, z) におけるベクトル量を表すものとする。導体円柱棒の電気伝導率は r の関数として $\sigma(r) = \sigma_0 \left(\frac{r}{a}\right)^3$ で与えられている。この導体円柱棒の内外に時刻 t に依存したような磁束密度 $B_{ex}(r, \varphi, z, t) = B_{ex}(t)e_z = (B_0 + \beta t)e_z$ を加えた (図 IV-2 参照)。ここで、 σ_0, B_0, β は正の定数である。また、導体円柱棒の内外で透磁率は μ_0 である。

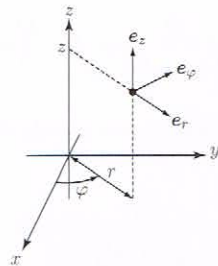


図 IV-1

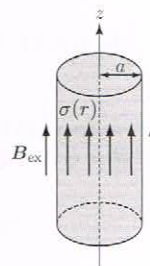


図 IV-2

- (1) 時刻 t で、位置 (r, φ, z) における電界 $E(r, \varphi, z, t)$ と電流密度ベクトル $i(r, \varphi, z, t)$ を求めなさい。
- (2) 時刻 t で、導体円柱棒中の $r_1 < r < r_2$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $z_0 < z < z_0 + \ell$ で指定される領域に発生する単位時間あたりのジュール熱 $P(r_1, r_2, t)$ を求めなさい。ここで、 $0 < r_1 < r_2 < a$, $\ell > 0$ である。
- (3) 導体円柱棒中を流れる全電流が、時刻 t で、位置 (r, φ, z) につくる磁束密度 $B'(r, \varphi, z, t)$ を求めなさい。